# パワートランジスタモジュール

#### **POWER TRANSISTOR MODULE**

■特長: Features
●高耐圧 High Voltage
●大電流 High Current

●hfe が高い High D.C. Current Gain

● 非絶縁形 Non-Insulated Type ■用途:Applications

●大電力スイッチング High Power Switching

●AC モータ制御 A.C Motor Controls

●無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

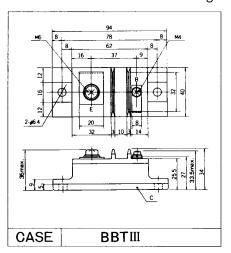
●DC モータ制御 D.C Motor Controls

■定格と特性: Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格:Absolute Maximum Ratings

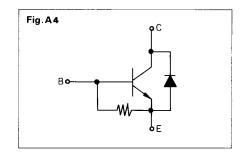
Item	s	Symbols	Ratings	Units	
コレクタ・ベース間電圧		V <sub>CBO</sub>	1000	V	
コレクタ・エミッタ間電圧		V <sub>CEO</sub>	1000	V	
コレクタ・エミッタ間電圧		V <sub>CEO(SUS)</sub>		٧	
エミッタ・ベース間電圧		V <sub>EBO</sub>	6	٧	
	DC	lc	200	Α	
コレクタ電流	1ms	ļc <sub>P</sub>	500	Α	
	DC	-Ic	200	, A	
ベース電流	DC	lB	80	A	
ハース电池	1ms	IBP	160	A	
	one Transistor	Pc	1500	W	
コレクタ損失		Pc		W	
接合部	温度	Tj	+150	°C	
保存	温 度	Tstg	-40~+125	°C	
重	量	m	450	g	
絶縁 耐圧	絶縁耐圧 AC.1min			V	
	ナトルク	Mounting *1	45	kg·cm	
締 付 け		Terminals <b>※ 2</b>	17	kg·cm	
			45	kg · cm	

# ■外形寸法: Outline Drawings



### ■等価回路

## Equivalent Circuit Schematic



#### Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;

M6: 35~40 kg·cm

※2: 推奨値 Recommendable Value;

M4: 13~15 kg·cm M6: 35~40 kg·cm

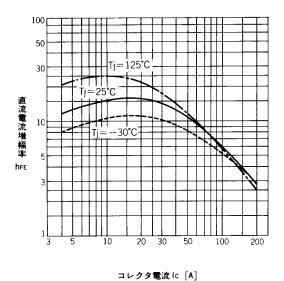
### ●電気的特性: Electrical Characteristics (Tj=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Тур	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CBO</sub>	I <sub>CBO</sub> =1mA	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	I <sub>CEO</sub> =1mA	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO(SUS)</sub>					V
	V <sub>CEX</sub> (SUS)					V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	I <sub>EBO</sub> = 800mA	6			V
コレクタしゃ断電流	Ісво	V <sub>CBO</sub> =1000V			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EBO</sub> =6V			800	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	-V <sub>CE</sub>	-I <sub>C</sub> =200A			2.5	V
直流電流増幅率	hre	$I_C = 120A$ , $V_{CE} = 5V$	4			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE(Sat)</sub>	Ic=120A, IB=60A			1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V <sub>BE(Sat)</sub>	IC-120A, IB-00A			2.0	V
スイッチング時間	ton					μs
	t <sub>stg</sub>					μS
	tr					μS
逆回復時間	trr	$-I_C = 200A$ , $V_{BE} = -6V$ , $-di/dt = 200A/\mu s$			0.7	μS

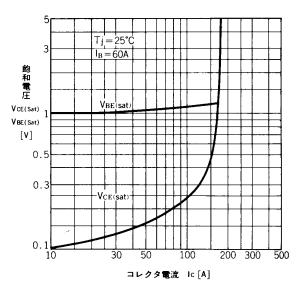
#### ●熱的特性: Thermal Characteristics

	Items		Symbols	Test Conditions	Min	Тур	Max	Units
熱	抵	抗	R <sub>th(j-c)</sub>	Transistor			0.083	°C/W
熱	抵	抗	R <sub>th(j-c)</sub>	Diode			0.2	°C/W
熱	抵	抗	R <sub>th(c-f)</sub>	With Thermal Compound		0.05		°C/W

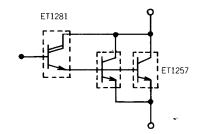
## ■特性曲線:Characteristics

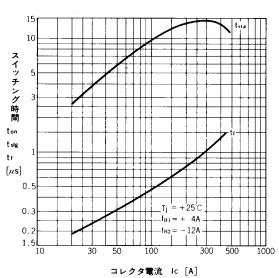


直流電流増幅率-コレクタ電流特性 DC Current Gain

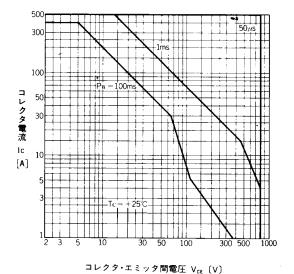


**飽和電圧 – コレクタ電流特性** Base and Collector Saturation Voltage

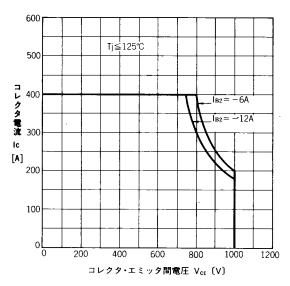




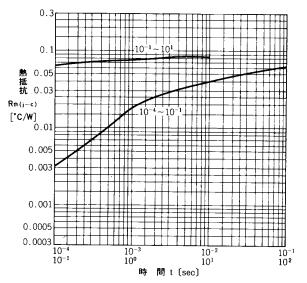
スイッチング時間 – コレクタ電流特性 Switching Time



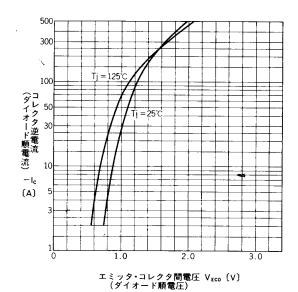
安全動作領域特性(非繰返し) Safe Operating Area



安全動作領域(逆パイアス) Reverse Biased Safe Operating Area



過渡熟抵抗(トランジスタ)特性 Transient Thermal Resistance (Transistor)



(ダイォード順電圧) 高速フリーホイリングダイオード順電圧 Forward Voltage of Free Wheeling Diode